【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成26年7月24日(2014.7.24)

【公表番号】特表2013-536011(P2013-536011A)
【公表日】平成25年9月19日(2013.9.19)
【年通号数】公開・登録公報2013-051
【出願番号】特願2013-523165(P2013-523165)
【国際特許分類】
Ａ６１Ｍ　25/00　(2006.01)
Ａ６１Ｂ　18/12　(2006.01)
Ａ６１Ｍ　25/01　(2006.01)
Ａ６１Ｂ　5/0408　(2006.01)
Ａ６１Ｂ　5/0478　(2006.01)
Ａ６１Ｂ　5/0492　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６１Ｍ　25/00　４８０
Ａ６１Ｂ　17/39　３１０
Ａ６１Ｍ　25/00　４５０Ｚ
Ａ６１Ｂ　5/04　３００Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成26年6月9日(2014.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
灌注アブレーションカテーテルのための電極アセンブリであって、
近位シャンク部及び遠位部を有する位置決め磁石本体と、
灌注流体を受け取るように構成された分散キャビティと、前記流体を送達するための遠位出口ポートを有する前記キャビティに結合された灌注通路とを有するマニホルドであって、前記キャビティおよび前記潅注通路が前記本体から隔離されている、マニホルドと、
前記本体を包囲する外側カプセルであって、遠位アブレーション面を含む導電材料を含む、カプセルと、
を備えるアセンブリ。
【請求項２】
前記位置決め磁石が、永久磁石、希土類元素を含む永久磁石および電磁石のうちの１つを含む、請求項１に記載のアセンブリ。
【請求項３】
前記永久磁石が、ネオジム鉄ホウ素（ＮｄＦｅＢ）材料を含む、請求項２に記載のアセンブリ。
【請求項４】
前記マニホルドが、前記分散キャビティを有しかつ軸に沿って延在する管状部を含み、前記管状部が、前記流体を受け取るように構成された近位端部を含み、前記灌注通路が、前記管状部の遠位部から延在し、前記潅注通路が、前記管状部と流体連通し、前記マニホルドが、前記本体内の対応する凹部に配置されている、請求項１～３のいずれかに記載のアセンブリ。

【請求項５】
前記本体内の前記対応する凹部が、前記マニホルドの前記管状部を受け取るように構成された中心に配置された長手方向に延在する孔を含む、請求項４に記載のアセンブリ。
【請求項６】
前記潅注通路に関連する前記出口ポートが、遠位出口ポート、側部出口ポートおよび角度付き出口ポートのうちの１つを含む、請求項１～５のいずれかに記載のアセンブリ。
【請求項７】
前記灌注通路が半径方向に延在する灌注通路である、請求項１～６のいずれかに記載のアセンブリ。
【請求項８】
前記本体および前記マニホルドが、軸に沿って延在し、前記灌注通路が、軸方向に延在する灌注通路である、請求項１～７のいずれかに記載のアセンブリ。
【請求項９】
前記カプセルが導電性コーティングを含む、請求項１～８のいずれかに記載のアセンブリ。
【請求項１０】
前記コーティングが、
（ｉ）前記本体の外面のＮｉ－Ｎｉ材料の第１層、前記第１層の上の金（Ａｕ）材料を含む第２層、および前記第２層の上にプラチナ（Ｐｔ）材料を含む第３層と、
（ｉｉ）前記本体の外面のＮｉ－Ｎｉ材料の第１層、前記第１層の上のチタン（Ｔｉ）材料を含む第２層、および前記第２層の上のプラチナ（Ｐｔ）材料を含む第３層と、
のうちの一方を含む、請求項９に記載のアセンブリ。
【請求項１１】
前記カプセルが、（ｉ）前記本体の前記遠位部を覆うように構成されたカップ状先端キャップと、（ｉｉ）前記シャンク部を包囲するように構成された円柱状シャンクカバーとを含み、前記先端キャップが前記灌注出口ポートに対応する少なくとも１つの穴を含む、請求項１～１０のいずれかに記載のアセンブリ。
【請求項１２】
前記本体の内部孔に結合された遠位端部と近位端とを有する安全線をさらに含む、請求項１～１１のいずれかに記載のアセンブリ。